Оптические свойства ортоферрита тулия TmFeO₃

© П.А. Усачёв, Р.В. Писарев, А.М. Балбашов*, А.В. Кимель**, А. Kirilyuk**, Th. Rasing**

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

* Московский энергетический институт,

111250 Москва, Россия

** Institute of Molecules and Materials, Radboud University Nijmegen,

6525 ED Nijmegen, The Netherlands

E-mail: usachev@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 11 февраля 2005 г.)

Исследованы оптические свойства ромбического ортоферрита тулия TmFeO₃ в спектральном диапазоне от 0.64 до 5.4 eV. В области слабого поглощения ниже 2.2 eV определены энергии локализованных оптических переходов в редкоземельном ионе Tm³⁺ и в ионе железа Fe³⁺. Методом спектроскопической эллипсометрии получена дисперсионная зависимость действительной и мнимой частей главных показателей преломления в направлении трех кристаллографических осей. В области сильного поглощения выше 2.2 eV определены энергии шести переходов с переносом заряда. Экспериментальные данные хорошо согласуются с представлениями о преобладающем влиянии переходов с переносом заряда в октаэдрических комплексах FeO₆⁹⁻ на оптические свойства ортоферритов. Измерены оптическое двупреломление и его температурная зависимость для трех главных направлений распространения света и выделен анизотропный магнитный вклад в двупреломление в области спин-ориентационных переходов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 03-02-17575 и 04-02-16599), программы Президиума РАН "Низкоразмерные квантовые структуры", Европейской программы EU RTN network DYNAMICS, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), а также de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).

1. Введение

Сильно коррелированные соединения переходных металлов 3*d*-группы уже в течение нескольких десятилетий находятся в фокусе интенсивных исследований, что отражено в многочисленных монографиях и обзорах. Ионы переходных металлов в таких соединениях полностью или частично определяют их магнитные, оптические и другие свойства, что связано в первую очередь с сильными электронными корреляциями и тесным взаимодействием между спиновыми, зарядовыми и орбитальными степенями свободы соединений 3d-металлов. В качестве яркого примера проявления таких корреляций можно привести высокотемпературную сверхпроводимость в оксидных соединениях меди [1], явление колоссального магнитосопротивления в редкоземельных манганитах [2] и др. Характер электронных состояний и природа фундаментального края поглощения в диэлектрических соединениях переходных металлов описываются подчас противоречивыми теориями, а экспериментальные исследования приводят в ряде случаев к неоднозначным результатам. Например, в недавней работе [3] особенность спектра LuMnO3 в виде необычно сильной и узкой линии поглощения около 1.6 eV отнесена к разрешенному по симметрии локальному d-d переходу в ионе Mn³⁺, в то время как в работе [4] эта линия в аналогичном гексагональном манганите YMnO₃ и других соединениях была приписана переходу с переносом заряда от кислорода О²⁻ к марганцу Мп³⁺. Еще одним примером могут служить оптические свойства

многочисленных оксидов трехвалентного иона железа Fe³⁺, находящегося в октаэдрическом кислородном окружении с примерно одинаковыми расстояниями железокислород. В прозрачных FeBO₃ и GdFe₃(BO₃)₄ [5], в среднепрозрачных ферритах-гранатах типа Y₃Fe₅O₁₂ [6], ортоферритах типа YFeO₃ и галлате железа GaFeO₃ [7,8] и в совершенно непрозрачном в видимом свете гематите α -Fe₂O₃ [9] положение фундаментального края поглощения существенно зависит от кристаллической структуры, химического состава и, по-видимому, удельной концентрации ионов железа на элементарную ячейку, что приводит к сильным изменениям интенсивностей запрещенных d-d переходов, разрешенных переходов с переносом заряда и, следовательно, оптических свойств материалов.

Характерным представителем соединений оксидов переходных металлов являются редкоземельные ортоферриты RFeO₃, где R — ионы редкоземельных элементов от La до Lu [10–12]. Они обладают распространенной и хорошо известной структурой перовскита, которая в силу своей относительной простоты позволяет проводить первопринципные (*ab initio*) и другие неэмпирические расчеты энергетического спектра, электронной структуры и обменных взаимодействий комплексов FeO₆^{9–} [13,14]. В редкоземельных ортоферритах в отличие от идеальных перовскитов происходит достаточно сильное искажение кислородного окружения катиона R³⁺. Октаэдрическое окружение иона Fe³⁺ также искажено, что приводит к расщеплению e_g - и t_{2g} -состояний переходного иона [13]. Некубические искажения идеальной структуры перовскита лежат в основе таких явлений, как магнитная и оптическая анизотропия, а их микроскопической основой являются локальные искажения кристаллического поля в комплексах FeO_6^{9-} . Особо следует отметить необычайно большой магнитооптический эффект Фарадея в ортоферритах в видимой и ближней инфракрасной области спектра, где эти материалы характеризуются относительно высокой прозрачностью [15].

Насколько нам известно, в настоящее время в литературе отсутствуют детальные исследования оптического поглощения, показателей преломления и оптической анизотропии ортоферритов. Постановка таких исследований приобрела в последнее время большую актуальность в связи с недавними экспериментами [16] по воздействию на ортоферрит тулия короткого лазерного импульса, приводящего к сверхбыстрому изменению намагниченности с характерными временем в несколько пикосекунд. В настоящей работе приводятся результаты исследований оптических свойств TmFeO3. Изучены спектры поглощения в области энергий 0.64-2.2 eV, с использованием метода спектроскопической эллипсометрии в области 0.64-5.4 eV исследована дисперсия действительной и мнимой частей комплексного показателя преломления вдоль трех кристаллографических осей, изучено оптическое двупреломление и его температурная зависимость на отдельных длинах волн. Полученные результаты, по нашему мнению, позволяют ставить более обоснованные эксперименты по изучению спиновой динамики оксидных магнетиков.

2. Оптические свойства

Кристаллическая симметрия редкоземельных ортоферритов RFeO3 описывается ромбической пространственной группой D_{2h}^{16} -*Pbmn* [10,11], а в элементарной кристаллической ячейке содержится четыре формульные единицы. По своей магнитной структуре ортоферриты являются неколлинеарными антиферромагнетиками [11,17,18]. При высоких температурах в них обычно реализуется состояние, соответствующее направлению вектора антиферромагнетизма $\mathbf{G} = (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_3)$ $(-M_4)/4$ вдоль оси *x* и вектора слабого ферромагнитного момента $\mathbf{F} = (\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_3 + \mathbf{M}_4)/4$ вдоль оси *z*, где M₁, M₂, M₃, M₄ — магнитные моменты четырех подрешеток ионов железа. С понижением температуры для целого ряда ортоферритов, включая тулиевый, наблюдается спиновая переориентация, соответствующая переходу к состоянию с направлением вектора F вдоль оси х.

Использовавшиеся в наших экспериментах монокристаллы TmFeO₃ были выращены методом бестигельной зонной плавки с оптическим нагревом [19]. Ориентация кристаллов проводилась рантегнографическим методом. Ортоферриты являются оптически двухосными кристал-



Рис. 1. Неполяризованный спектр поглощения TmFeO₃ при распространении света вдоль оси *z* при температуре 15 К.

лами, и потому образцы были приготовлены в виде пластинок, полированных до толщины $80-100 \,\mu$ m, с нормалью, ориентированной с точностью несколько градусов перпендикулярно кристаллографическим осям x, y, z, а также пластинок с нормалью, направленной примерно вдоль оптической оси, лежащей в плоскости yz.

На рис. 1 показана спектральная зависимость коэффициента поглощения ортоферрита тулия TmFeO3 в диапазоне от 0.62 до 2.2 eV, измеренная на спектрофотометре Cary 2300. Спектральная характеристика показана при распространении света вдоль оси z при температуре 15 К. В этой области спектра поглощение определяется переходом в ионах железа в кристаллическом поле и переходами на возбужденные состояния мультиплета тулия. Ион трехвалентного железа содержит пять электронов на 3d оболочке, находящихся в высокоспиновом состоянии и заполняющих единственный спиновой секстет и орбитальный синглет ⁶S, который лежит ниже остальных термов [20]. Оптические d-dпереходы в кристаллическом поле соответствуют переходам с основного состояния ${}^{6}A_{1g}$ на спиновые квартеты и дублеты и, следовательно, запрещены по спину и четности. Эти переходы приводят лишь к относительно слабому поглощению за счет частичного снятия запретов некубическими искажениями кристаллического поля, колебаниями решетки, спин-орбитальным взаимодействием и другими возмущениями. Первым возбужденным состоянием свободного иона железа является терм ${}^{4}G$, который в октаэдрическом кристаллическом поле расщепляется на уровни ${}^{4}T_{1g}$, ${}^{4}T_{2g}$ и ${}^{4}E_{g}$, ${}^{4}A_{1g}$. Переходы на уровни ${}^{4}T_{1g}$ и ${}^{4}T_{2g}$ лежат ниже переходов с переносом заряда, и поэтому их можно наблюдать в виде широких полос поглощения с центрами около 1.22 и 1.72 eV [7,21]. Однако эти переходы никак не проявляются в спектрах коэффициента преломления (рис. 2). Переход на уровни ${}^{4}E_{g}$, ${}^{4}A_{1g}$ лежит вблизи переходов с переносом заряда. Он имеет уже достаточно высокую интенсивность и потому проявляется в спектрах коэффициента преломления.

Узкие расщепленные линии поглощения с энергиями 0.73, 1.01, 1.55, 1.8 и 1.87 eV обусловлены переходами в подрешетке тулия с уровней основного состояния ${}^{3}H_{6}$ на уровни возбужденных состояний ${}^{3}H_{4}$, ${}^{3}H_{5}$, ${}^{3}F_{4}$, ${}^{3}F_{3}$ и ${}^{3}F_{2}$ соответственно [22,23]. Можно отметить хорошо выраженные переходы в тулии на подуровни мультиплета ${}^{3}F_{4}$, которые находятся в диапазоне энергий титансапфирового лазера и могут быть использованы для накачки магнитной системы редкоземельного иона с целью исследования сверхбыстрой динамики намагниченности. С повышением температуры линии поглощения в ионах тулия значительно уширяются и в области температур ориентационных фазовых переходов они уже сливаются в полосы поглощения [23].

Комплесный коэффициент преломления тулиевого ортоферрита при комнатной температуре был исследован методом отражательной спектроскопической эллипсометрии при помощи автоматического эллипсометра с вращающимся анализатором. Поскольку этот материал является сильно анизотропным, общая обратная задача эллипсометрии не является тривиальной [24]. Действительная и мнимая части комплексного показателя преломления N = n - ik определялись путем приближенного решения эллипсометрического уравнения для оптически двуосных кристаллов [25]. Наибольшая погрешность данного метода, проявляющаяся в завышенном значении k, имеет место в области слабого поглощения 0.62-2.2 eV. Эта погрешность связана с упрощениями, принятыми в использованной модели, которая, в частности, не учитывает неровности поверхностного слоя, наличия в нем дефектов и поверхностных напряжений, возникших при механической обработке. Тем не менее данная модель правильно отражает качественную зависимость комплексного показателя преломления, а совместное использование результатов эллипсометрических измерений на отражение и на пропускание позволяет с достаточной точностью проводить количественные оценки. В частности, используя три главных значения абсолютного показателя преломления, можно определить направления оптических осей в кристалле и их дисперсию.

На рис. 2 и 3 показаны результаты измерений соответственно действительной и мнимой частей главных показателей преломления TmFeO₃ в направлении трех кристаллографических осей. Основные закономерности этих спектров могут быть описаны в рамках теории кристаллического поля, согласно которой электронная конфигурация основного состояния комплексов FeO₆^{9–} основных оптических центров в ортоферритах характеризуется наличием нескольких заполненных кислородных валентных орбиталей 2*p* типа, а также наполовину заполненных t_{2g} и e_g орбиталей иона железа 3*d* типа. Участок спектра выше 3.0 eV, как это видно на рис. 3, характеризуется более сильным олектродипольными



Рис. 2. Дисперсия действительной части показателя преломления TmFeO₃ в направлении трех кристаллографических осей, рассчитанная из эллипсометрических измерений на отражение. На вставке: дисперсионная зависимость двупреломления, определенная из эллипсометрических измерений на пропускание.



Рис. 3. Дисперсия мнимой части показателя преломления TmFeO₃ в направлении трех кристаллографических осей. Цифрами отмечены энергии осцилляторов (см. также рис. 4 и таблицу), найденные из формулы (1).

переходами. В соответствии с правилами отбора по четности и спину разрешены шесть электродипольных переходов с переносом заряда ${}^{6}A_{1g} \rightarrow {}^{6}T_{1u}$, связанных с одноэлектронными переходами с уровней $t_{2u}(\pi)$, $t_{1u}(\pi)$, $t_{1u}(\sigma)$ на уровни t_{2g} и e_g [13], энергии которых находятся выше 3 eV.

Расчеты проводились в приближении кубического кристаллического поля, но, как показано далее, число наблюдаемых переходов превосходит предсказания расчетов, и это является четким экспериментальным доказательством важности некубических искажений в формировании электронной структуры ортоферритов и как следствие анизотропии магнитных, оптических и магнитооптических свойств. Результаты, приведенные на рис. 2 и 3, позволяют определить параметры переходов, рассчитать спектр комплексной диэлектрической

j	e^{xx}			ϵ^{yy}			ε^{zz}		
	E_j, eV	γ_j, eV	f_j	E_j , eV	γ_j, eV	f_j	E_j , eV	γ_j, eV	f_j
1	2.67(1)	0.18(3)	0.13(3)	2.665(5)	0.26(3)	0.33(6)	2.668(5)	0.18(3)	0.15(3)
2	2.97(1)	0.32(4)	0.8(2)	2.961(9)	0.37(4)	1.3(3)	2.993(9)	0.42(3)	1.9(2)
3	3.19(1)	0.41(2)	1.9(2)	3.19(1)	0.43(2)	2.2(3)	3.20(1)	0.33(3)	0.8(2)
4	3.828(5)	0.39(2)	3.6(6)	3.812(3)	0.35(1)	2.7(2)	3.827(3)	0.32(1)	1.8(2)
5	4.13(1)	0.69(9)	6(1)	4.17(1)	0.70(9)	5(1)	4.146(8)	0.61(7)	4(1)
6	4.70(3)	1.12(8)	8.3(9)	4.61(5)	1.34(7)	13(2)	4.61(2)	1.17(5)	14(1)
7	5.50(2)	0.29(5)	1.4(3)	5.47(3)	0.08(3)	0.26(9)	5.56(3)	0.51(8)	2.0(4)
	\mathcal{E}_0	$\mathcal{E}_{1,b}$	$\mathcal{E}_{2,b}$	\mathcal{E}_0	$\mathcal{E}_{1,b}$	$\mathcal{E}_{2,b}$	\mathcal{E}_0	$\mathcal{E}_{1,b}$	$\mathcal{E}_{2,b}$
	3.78(2)	0.047(5)	0.253(5)	3.81(4)	0.006(6)	0.262(7)	3.54(3)	0.052(5)	0.225(5)

Параметры составляющих осцилляторов компонент тензора диэлектрической проницаемости, найденные из разложения экспериментальных данных в соответствии с формулой (1)

функции $\varepsilon = \varepsilon_1 - i\varepsilon_2 = (n - ik)^2$ и привести его разложение на отдельные осцилляторы в соответствии с выражением

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_b E + \sum_j \frac{f_j}{E_j^2 - E^2 - iE\gamma_j},\tag{1}$$

где ε_0 — действительная, не зависящая от энергии фотона добавка; ε_b — комплексный коэффициент, который описывает общее влияние осцилляторов, расположенных значительно выше диапазона обрабатываемых значений энергий E; E_j — резонансные энергии осцилляторов; f_j и γ_j — параметры, описывающие силу осцилляторов и их затухание соответственно. В результате обработки экспериментальных данных было найдено семь осцилляторов, один из которых относится к локализованному переходу на уровни 4E_g , ${}^4A_{1g}$ при энергии $E_1 = 2.67 \text{ eV}$, и шесть переходов с переносом заряда в комплексах FeO_6⁹⁻, имеющих резонансные энергии в диапазоне от 2.96 до 5.56 eV. Найденные параметры



Рис. 4. Разложение экспериментального спектра мнимой части zz компоненты тензора диэлектрической проницаемости по функциям Лоренца (j = 1, 2, ..., 7) в соответствии с формулой (1).



Рис. 5. Схема локализованных переходов и переходов с переносом заряда в комплексе FeO_6^{9-} по результатам данной работы, значениям, полученным в [8] и рассчитанным в [13].

осцилляторов для всех диагональных компонент тензора диэлектрической проницаемости приведены в таблице.

Для мнимой части диэлектрической функции выражение (1) представляет собой разложение по функциям Лоренца, и такое разложение экспериментального спектра для компоненты ε^{zz} тензора диэлектрической проницаемости показано на рис. 4. Из рисунка видно хорошее соответствие экспериментальных данных с расчетами на основе найденных параметров разложения. На рис. 5 показаны энергии переходов в комплексах FeO₆⁹⁻, полученные в настоящей работе в сравнении со значениями, приведенными в работе [8], и теоретическим расчетом, выполненным в работе [13]. Отметим, что в отличие от [8] эллипсометрический метод в сочетании с использованной процедурой обработки результатов позволил найти более точные параметры переходов с переносом заряда, расщепленных в некубическом кристаллическом поле.

3. Дисперсия и температурная зависимость двупреломления

Редкоземельные ортоферриты являются оптически двуосными кристаллами и обладают естественным двупреломлением, что приводит к изменению состояния поляризации распространяющегося сквозь такую среду света с длиной волны λ. В области энергий 0.64-2.1 eV они относительно прозрачны, что позволяет путем эллипсометрических измерений на пропускание получить дисперсионную зависимость двупреломления. Для каждой длины волны света, линейно поляризованного под углом 45° к кристаллографическим осям, в конфигурации нормального падения определялась разность фаз между s- и p-поляризациями света, прошедшего через образец. Затем путем учета количества полных оборотов, которые претерпевает измеренная разность фаз при изменении длины волны, определялся полный фазовый угол σ , на который изменилось состояние поляризации волны на выходе из пластинки толщиной d. Разность показателей преломления Δn (двупреломление) для каждой длины волны находилась из соотношения

$$\sigma = \frac{2\pi d\Delta n}{\lambda}.$$
 (2)

Дисперсионные зависимости двупреломления показаны на вставке к рис. 2. Оптическая анизотропия ортоферритов определяется главным образом вкладом электродипольных переходов с переносом заряда в октаэдрических комплексах FeO_6^{9-} [13]. В области спектра 0.64–2.1 eV двупреломление слабо зависит от энергии фотона и растет по мере приближения к области сильного поглощения, расположенной выше 2.2 eV. Эллипсометрические измерения на пропускание с погрешностью измерений $\pm 5 \cdot 10^{-4}$ дали следующие значения двупреломления на длине волны 800 nm (1.55 eV):

$$\Delta n_{xy} = 0.0405, \quad \Delta n_{xz} = 0.026, \quad \Delta n_{yz} = 0.067.$$
 (3)

На длине волны 1550 nm (0.8 eV) получены значения двупреломления

$$\Delta n_{xy} = 0.0382, \quad \Delta n_{xz} = 0.0246, \quad \Delta n_{yz} = 0.0615.$$
 (4)

Эти значения хорошо совпадают с теоретической оценкой $\Delta n_{xy} = 0.0389$, приведенной в [10], и отличаются от экспериментальных значений $\Delta n_{xy} = 0.0312$, $\Delta n_{xz} = 0.0205$, приведенных в [26], что, видимо, связано с несовершенством использовавшейся в этой работе методики определения двупреломления.

С понижением температуры вследствие изменения магнитной анизотропии в $TmFeO_3$ наблюдается процесс спонтанной спиновой переориентации. Она протекает в виде непрерывного поворота вектора ферромагнитного момента **F** из положения вдоль кристаллографической оси *z* при температуре T_2 до положения вдоль оси *x* при температуре T_1 . Эти точки являются точками фазовых



Рис. 6. Температурная зависимость двупреломления вдоль трех главных направлений в кристалле. Аномалии двупреломления имеют место при температурах ориентационных переходов T_1 и T_2 . Значения двупреломления при комнатной температуре приведены в формуле (3).

переходов второго рода $(\Gamma_4 \to \Gamma_{24} \to \Gamma_2)$ [11], в которых имеют место аномалии физических свойств.

Для исследования температурной зависимости двупреломления образец был помещен между поляризатором и скрещенным с ним анализатором. Фазовый сдвиг R падающего на образец излучения с линейной поляризацией под углом 45° к кристаллографическим осям изменялся с помощью акустического модулятора с частотой f. Сигнал на фотодетекторе имел гармонические составляющие на частотах f и 2f, амплитуды которых равны $J_1(R_0) \sin \theta$ и $J_2(R_0) \cos \theta$ соответственно, где $J_i(R_0)$ — функция Бесселя, R_0 — амплитуда модуляции фазового сдвига, θ — разность фаз для света в s- и p-поляризации. Температурная зависимость двупреломления определялась с помощью соотношения (2) по известному из эллипсометрических измерений при комнатной температуре полному фазовому углу σ для данной длины волны и зависящей от температуры разности фаз θ , определенной из соотношения

$$tg\theta = \frac{V_{1f}}{V_{2f}} \frac{J_2(R_0)}{J_1(R_0)},$$
 (5)

где V_{1f} и V_{2f} — амплитуды сигналов, измеренные соответственно на частотах f и 2f.

На рис. 6 приведена зависимость линейного двупреломления от температуры, на которой видны два ориентационных фазовых перехода второго рода при температуре 83 и 93 К. Согласно теории Ландау [11,27], возможные спиновые конфигурации находятся путем минимизации термодинамического потенциала по векторам **F** и **G**

$$\Phi = \Phi_0 + K_1(T)\sin^2\Theta + K_2\sin^4\Theta, \qquad (6)$$

где Φ_0 — часть энергии, не зависящая от ориентации спинов; K_1 и K_2 — первая и вторая константы анизотропии; Θ — угол между антиферромагнитным вектором **G** и осью *x* ромбического кристалла. Переориентация спинов осуществляется путем двух фазовых переходов второго рода типа $\Gamma_4(G_xF_z) \rightarrow \Gamma_{24} \rightarrow \Gamma_2(G_zF_x)$, сопровождаемых переориентацией магнитного момента в плоскости *xz* кристалла. Помимо равновесных состояний с ориентацией вектора **F** вдоль оси *z* ($T > T_2$) и оси *x* кристалла ($T < T_1$) в интервале $T_1 < T < T_2$ реализуется состояние, при котором вектор **F** направлен под углом Θ к оси *z*

$$\sin^2 \Theta = -K_1/2K_2. \tag{7}$$

Изменение двупреломления при спин-ориентационных переходах обусловлено как температурной зависимостью кристаллографического вклада в двупреломление, который включает в себя также изотропный магнитный вклад, так и изменением анизотропного магнитного вклада [28]. Изотропный магнитный вклад можно найти из температурных изменений абсолютных показателей преломления. В настоящей работе исследованы лишь температурные изменения двупреломления, что позволяет найти только анизотропный магнитный вклад. Изменение диагональных компонент тензора диэлектрической проницаемости

$$\Delta \varepsilon_{ii} = \beta_{iijk} G_j G_k \tag{8}$$

дает величину двупреломления в фазах Г₂ и Г₄

$$\Delta n_{yz}(\Gamma_2) = \frac{\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz}}{2n} + \frac{(\beta_{yyzz} - \beta_{zzzz})G_z^2}{2n}, \qquad (9)$$

$$\Delta n_{yz}(\Gamma_4) = \frac{\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz}}{2n} + \frac{(\beta_{yyxx} - \beta_{zzxx})G_x^2}{2n}.$$
 (10)

Здесь первое слагаемое описывает кристаллографический вклад в двупреломление, а второе — соответствует анизотропному магнитному вкладу. Этот вклад появляется, если $\beta_{yyxx} - \beta_{zzxx} - \beta_{yyzz} + \beta_{zzzz} \neq 0$, что в принципе разрешено лишь в некубических кристаллах. Из рис. 6 следует, что анизотропный магнитный вклад в двупреломление максимален для $\Delta n_{yz}^{mag} \approx 5 \cdot 10^{-4}$ и минимален для $\Delta n_{xy}^{mag} \approx 1 \cdot 10^{-4}$. Именно этот вклад был использован для мониторинга сверхбыстрой спиновой динамики в области ориентационных фазовых переходов, индуцированных 100-фемтосекундными лазерными импульсами [16].

4. Заключение

Основные результаты проведенного исследования оптических свойств ортоферрита тулия можно сформулировать следующим образом.

1. В области прозрачности ниже 2.2 eV оптические d-d переходы в ионе железа Fe³⁺ с уровня основного состояния ${}^{6}A_{1g}$ на возбужденные уровни ${}^{4}T_{1g}$ и ${}^{4}T_{2g}$ наблюдаются в виде широких полос поглощения с максимумами около 1.22 и 1.72 eV соответственно. Переходы в подрешетке тулия с уровня основного состояния ${}^{3}H_{6}$ на уровни возбужденных состояний ${}^{3}H_{4}$, ${}^{3}H_{5}$, ${}^{3}F_{4}$, ${}^{3}F_{3}$ и ${}^{3}F_{2}$ наблюдаются в виде узких расщепленных линий поглощения со средними энергиями 0.73, 1.01, 1.55, 1.8 и 1.87 eV соответственно.

2. В области сильного поглощения наблюдаются локализованный переход ${}^{6}A_{1g} \rightarrow {}^{4}E_{g}$, ${}^{4}A_{1g}$ с энергией 2.67 eV и шесть переходов с переносом заряда в комплексах FeO₆⁹⁻, имеющих резонансные энергии в диапазоне от 2.96 до 5.56 eV. Число наблюдаемых переходов превосходит предсказания расчетов, и это является четким экспериментальным доказательством важности некубических искажений в формировании электронной структуры ортоферритов и, как следстиве, анизотропии магнитных, оптических и магнитооптических свойств.

3. В области спектра 0.64-2.1 eV оптическое двупреломление слабо зависит от энергии фотона и растет по мере приближения к области сильного поглощения, расположенной выше 2.2 eV. С понижением температуры имеют место аномалии двупреломления при температурах ориентационных переходов Т1 и Т2. Изменение двупреломления при спин-ориентационных переходах обусловлено температурной зависимостью кристаллографического вклада в двупреломление, который включает в себя также изотропный магнитный вклад, и температурной зависимостью анизотропного магнитного вклада. Из температурной зависимости двупреломления следует, что анизотропный магнитный вклад в двупреломление максимален для $\Delta n_{yz}^{mag} \approx 5 \cdot 10^{-4}$ и минимален для $\Delta n_{xy}^{mag} \approx 1 \cdot 10^{-4}$. Изменение этого вклада можно использовать для мониторинга сверхбыстрой спиновой динамики в области ориентационных фазовых переходов, индуцированных 100-фемтосекундными лазерными импульсами.

Авторы выражают признательность В.В. Павлову за предоставленную программу определения параметров осцилляторов и Х.-Ю. Веберу (H.-J. Weber) за помощь в измерении спектра поглощения.

Список литературы

 Model and Methods of High-T_C Superconductivity: Some Frontal Aspects. Vol. 1 / Eds by J.K. Srivastava and S.M. Rao. Nova Science Publishers (2003); Studies of High Temperature Superconductivity (Advances in Research and Applications) / Ed. by A. Narlikar. Nova Science Publishers. Vol. 41 (2002); Vol. 45 (2003).

- [2] Colossal Magnetoresistance, Charge Ordering and Related Properties of Manganese Oxides / Eds C.N.R. Rao and B. Raveau. World Scientific (1998). 356 p.
- [3] A.B. Souchkov, J.R. Simpson, M. Quijada, H. Ishibashi, N. Nur, J.S. Ahn, S.W. Cheong, A.J. Millis, H.D. Drew. Phys. Rev. Lett. 91, 027 203 (2003).
- [4] А.М. Калашникова, Р.В. Писарев. Письма в ЖЭТФ 78, 3, 175 (2003).
- [5] А.М. Калашникова, В.В. Павлов, Р.В. Писарев, Л.Н. Безматерных, М. Бауер, Т. Расинг. Письма в ЖЭТФ 80, 5, 339 (2004).
- [6] Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. Landolt-Börnstein, New Series, Springer-Verlag, Berlin (1991). Group III. Vol. 27e.
- [7] Р.В. Писарев. ФТТ 6, 2545 (1964); 7, 207 (1965).
- [8] F.J. Kahn, P.S. Pershan, J.P. Remeika. Phys. Rev. 186, 3, 891 (1969).
- [9] R.G. Burns. Mineralogical Applications of Crystal Field Theory. Cambridge University Press (1993). 551 p.
- [10] Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. Landolt-Börnstein, New Series, Springer-Verlag, Berlin (1994). Group III. Vol. 27 f3.
- [11] К.П. Белов, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, М. (1979). 317 с.
- [12] В.Д. Бучельников, Н.К. Даньшин, Л.Т. Цымбал, В.Г. Шавров. УФН 166, 6, 585 (1996).
- [13] А.И. Лихтенштейн, А.С. Москвин, В.А. Губанов. ФТТ 24, 12, 3596 (1982).
- [14] A.S. Moskvin, A.V. Zenkov, E.A. Ganshina, G.S. Krinchik, M.M. Nishanova. J. Phys. Chem. Sol. 54, 101 (1993).
- [15] A.K. Zvezdin, V.A. Kotov. Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials. Institute of Physics Publishing (1997).
- [16] A.V. Kimel, A. Kirilyuk, A. Tsvetkov, R.V. Pisarev, Th. Rasing. Nature 429, 6994, 850 (2004).
- [17] R.M. White, R.J. Nemanich, C. Herring. Phys. Rev. B 25, 1822 (1982).
- [18] Е.А. Туров, А.В. Колчанов, В.В. Меньшенин, И.Ф. Мирсаев, В.В. Николаев. Симметрия и физические свойства антиферромагнетиков. Физматлит, М. (2001). 560 с.
- [19] A.M. Balbashov, S.K. Egorov. J. Cryst. Growth 52, part 2, 498 (1981).
- [20] Э. Ливер. Электронная спектроскопия неорганических соединений. Мир, М. (1987). [А.В.Р. Lever. Inorganic Electronic Spectroscopy. Elsevier Science Publishers B.V. (1984)].
- [21] D.L. Wood, J.P. Remeika. J. Appl. Phys. 38, 1038 (1967).
- [22] G.H. Dieke. Spectra and Energy Levels of Rare Earth Ions in Crystals. Interscience Publishers, N.Y. (1968).
- [23] A.P. Malozemoff. J. Phys. Chem. Solids 32, 1669 (1971).
- [24] Р. Аззам, Н. Башара. Эллипсометрия и поляризованный свет. Мир, М. (1981). 584 с. [R.V.A. Azzam, N.M. Bashara. Ellipsometry and polarized light. North-Holland Publishing Company, Amsterdam (1997)].
- [25] D.E. Aspnes. J. Opt. Soc. Am. 70, 10, 1275 (1980).
- [26] М.В. Четкин, Ю.И. Щербаков, А.П. Воленко, Л.Д. Шевчук. ЖЭТФ 67, 3(9), 1027 (1975).
- [27] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика. Наука, М. (1976). 584 с.
- [28] J. Ferré, G.A. Gehring. Rep. Prog. Phys. 47, 5, 513 (1984).